# НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ім І.Сікорського

# ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ КАФЕДРА КЕОА

3BIT

#### ПРО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №3

3 КУРСУ

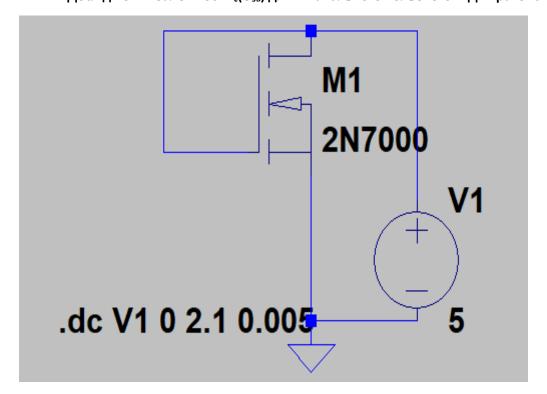
«Аналогова електроніка»

ТЕМА РОБОТИ: «Дослідження польового МДН транзистора з індукованим n-каналом»

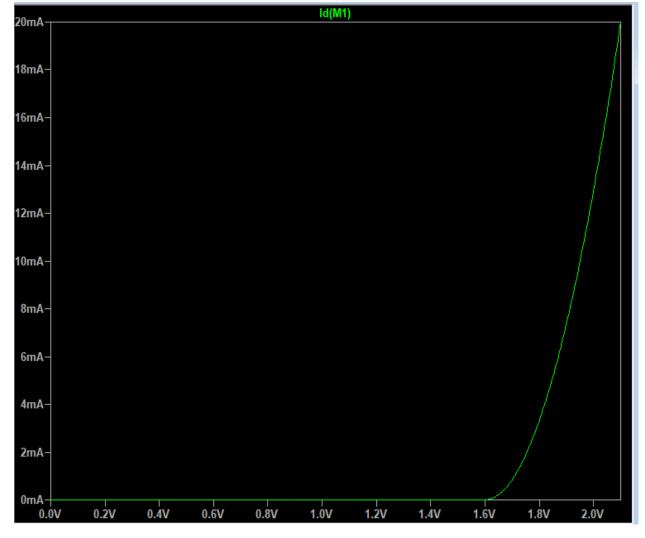
ВИКОНАВ: студент гр. Дк-61 Сидорчук Максим

ПЕРЕВІРИВ: доцент Короткий Є.В

#### 1. Дослідження залежності $I_c(U_{\scriptscriptstyle 3B})$ для n-канального польового МДН транзистора 2N7000



одержуємо наступний графік залежності I<sub>c</sub>(U<sub>зв</sub>):



ТАблиця залежності Струму каналу від напруги затвор-виток.  $I_c(U_{3B})$ :

Uзв, V	Ic, A
0,20	0,000000000000241
0,40	0,000000000000440
0,60	0,000000000000639
0,80	0,000000000000839
1,00	0,00000000001040
1,20	0,00000000001242
1,40	0,00000000001439
1,60	0,000005
1,80	0,003309
2,00	0,013050
2,20	0,028461

# Розрахунок порогової напруги Un:

U3B	Ic
1.8386878V	4.7009885mA
2.083371V	18.723306mA

$$Ic2=4\cdot Ic1=b/2(U3B2-U\pi)2$$

$$4.7009885 \text{M} = 500 * b * (1.8386878 - Up)^2$$

$$18.723306 M = 500 * b * (2.083371 - Up)^{2}$$

3 формул наведених на попередньому кроці можна визначити порогову напругу і параметр транзистору b

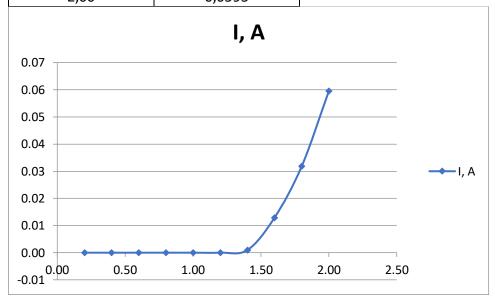
Uп=2U3B1-U3B2=2\*1.8386878-2.083371=1.5940046

#### b=0.15704

Uзв V	Струм стоку Ltspice	Струм стоку з формули	Похибка%
1,60	0,000005	0,000003	45,65
1,80	0,003309	0,003332	0,69
2,00	0,013050	0,012943	0,82
2,20	0,028461	0,028835	1,31

#### Реальні вимірювання

Изв	Ic	
0,20	0,00	
0,40	0,00	
0,60	0,00	
0,80	0,0000018	
1,00	0,00000361	
1,20	0,00001553	
1,40	0,000955	
1,60	0,0129	
1,80	0,0318	
2,00	0,0595	



#### Розрахунок порогової напруги Un:

Uзв	Ic
1.6V	12,9mA
2V	59,5mA

Іс1=b/2(Изв1-Ип)2

$$Ic2=4·Ic1=b/2(U3β2-Uπ)2$$

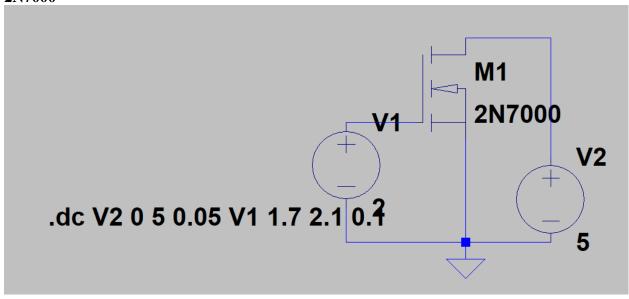
$$12,9M = 500 * b * (1.6 - Up)^2$$

$$59,5M = 500 * b * (2.083371 - Up)^2$$

3 формул наведених на попередньому кроці можна визначити порогову напругу і параметр транзистору b

b=0.16125

# 2. Дослідження залежності $I_c(U_{\mbox{\tiny BC}})$ для n-канального польового МДН транзистора 2N7000

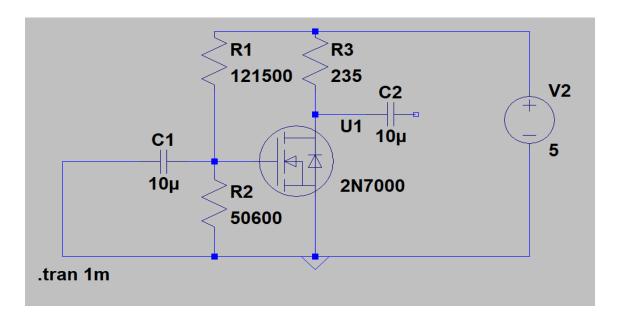


Варіюючи напругу Uзв (джерело V1) в діапазоні від 1.7 до 2.1 В з кроком 0.1 В та варіюючи напругу Uвс (джерело V2) в діапазоні від 0 до 5 В з кроком 0.05 В, визначте залежність  $I_c(U_{\infty})$  для різних значень напруг на затворі, одержавши сімейство вихідних статичних характеристик транзистора:



# 3. Дослідження підсилювача з загальним витоком на польовому МДН транзисторі 2N7000

R1	121500,00	Om
R2	50600,00	Om
R3	235,00	Om
C1	10,00	uF
C2	10,00	uF



3.2 Робоча точка при відсутності вхідного сигнулу

Симуляція:

Uзв0=1.47 V

Uвс0=4.307 V

Ic0=2.949 mA

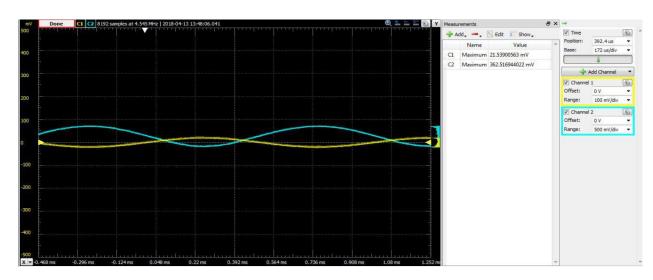
Реальні вимірювання:

Uзв0= 1,463V

Uвс0= 3,67 V

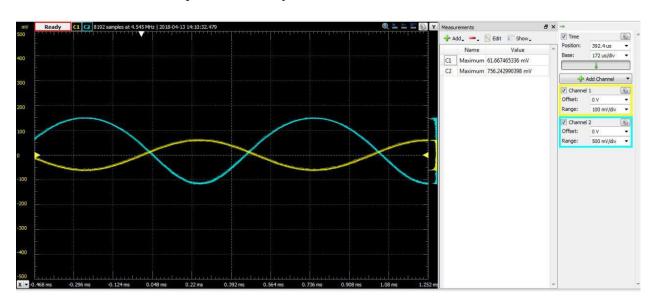
Ic0 = 5,67mA

3.3 Напругу вхідного сигналу амплітудою 20 мВ та частотою 1 КГц - жовтий графік.



ВИХ	ВХ	Ки_практичне
0,36200	0,02153	16,81

3.4 Визначення максимальної величини змінної напруги на вході, при якій схема виходить з лінійного режиму підсилення і починають виникати нелінійні спотворення сигналу на виході. U=60 mV



3.5

R1	121500,00	Om
R2	55250,00	Om
R3	235,00	Om
C1	10,00	
C2	10,00	uF

Uзв1=1,556 V

ΔUзв=0,093 V

Ic1=11,51 мА

 $\Delta$ Ic=5,84 мА

Визначимо передаточну провідність за формулою gm=ΔIc/ΔUзв

 $g_m$ =0,0628 м

 $K_u = g_m * R3 = 0.0628 * 235 = 14.758$ 

Передаточну провідність також можна розрахувати за формулою gm=b·(Uзв0-Uп)

 $g_m$ =0.16125 M \* (1.47-1.2) = 0.044

 $K_u = g_m * R3 = 0.044 * 235 = 10.34$ 

Висновок: було досліджено схему на біполярному транзисторі із індукованим п-каналом із загальним витоком. Спочатку було складена схема у режимі великого

сигналу, відсутній вхідний сигнал, для визначення точок спокою. Потім подали малий змінний сигнал який ми підсилюємо, виміряли амплітуди вхідного і вихідного сигналу і визначили коеф. Підсилення за напругою і порівняли його з розрахованим значенням.